**【注意】本様式は、「R24-07 次世代半導体デバイス」に応募するための様式です。他の分野に応募する場合は、その分野専用の申請書の様式を用いてください。**

**NIMS定年制研究職応募申請書**

顔写真

**Applicant ID：　　　　　　　　氏名：**

**（１）研究業績**

あなた（応募者）の研究業績、及び、その独創性について、日本語で記述してください。10.5ポイントのフォントを用いて、シングルスペースで、A4用紙4頁以内で作成してください。

青文字は削除してお使いください。（以下同様）

**（２）NIMSにおける研究計画**

この項目では、応募者の研究企画・提案能力を量ります。あなたが定年制研究者として採用された場合に、NIMSで行いたい研究の内容を、短期計画と中長期計画に分けて、日本語で記述してください。研究計画には、(a) 研究の背景と目的、(b) 研究計画、及び、(c) 期待される成果とその影響を含めること。

10.5ポイントのフォントを用いて、シングルスペースで、A4用紙2頁以内で作成してください。

**（３）出版物リスト**

原著論文、プロシーディングス、総説（レビュー）論文、招待講演、特許、著書の各項目別リストを作成してください。それぞれの項目で、発表年次を現在から順に過去にさかのぼり、通し番号を付して記入してください。申請者の名前には下線を引き、責任著者（corresponding author）にはアスタリスク記号（\*）を名前の後に付けてください。英語等で書かれたものは英語で記載し、日本語のものは日本語で記載してください。頁数に制限はありません。

尚、学術誌へ投稿中の論文を記入する場合は、掲載許可が下りているものに限ります。（投稿後、審査中のものは含めないこと。）

［原著論文］

論文毎に、著者名（掲載順）・論文タイトル・雑誌名・刊行号番号・開始頁－終了頁・発行年の順に記載してください。DOI（デジタルオブジェクト識別子）があれば、それを各論文の最後に付けてください。例〉(1) J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer\*, "Theory of Superconductivity", Phys. Rev. 108, 1175-1204 (1957). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRev.108.1175

(1)

(2)

適宜、番号を追加。（以下同様。）

［プロシーディングス］

　著者名（掲載順）・論文タイトル・国際会議等の名称・開催場所（都市・国など）と開催年・出版社名・出版された都市名と出版年・頁数の順に記載してください。DOI（デジタルオブジェクト識別子）があれば、それを各プロシーディングスの最後に付けてください。

(1)

(2)

［総説（レビュー）論文］

論文毎に、著者名（掲載順）・論文タイトル・雑誌名・刊行号番号・開始頁－終了頁・発行年の順に記載してください。DOI（デジタルオブジェクト識別子）があれば、それを各論文の最後に付けてください。

(1)

(2)

［招待講演］

著者名・発表タイトル・国際会議等の名称・開催場所（都市・国など）と開催年の順に記載してください。本応募の申請者自身が登壇発表した会議等についてのみ記載してください。（共著者・共同研究者など、申請者本人以外の者が登壇発表した場合は、リストに含めないでください。）

(1)

(2)

［特許］

発明者の名前（特許出願時に記載された順）・発明の名称・出願国・特許番号・日付の順に記載してください。特許登録済み・拒絶・出願中など、現在の状況を各特許の最後に記してください。

(1)

(2)

［著書］

全著者名・編集者（エディター）名・章の題目・書籍名・出版社名、発行された都市と発行年・章の頁番号の順に記載してください。

(1)

(2)